



2SB649 (3CA649)

2SB649A (3CA649A)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于低频功率放大/Purpose: Low frequency power amplifier.

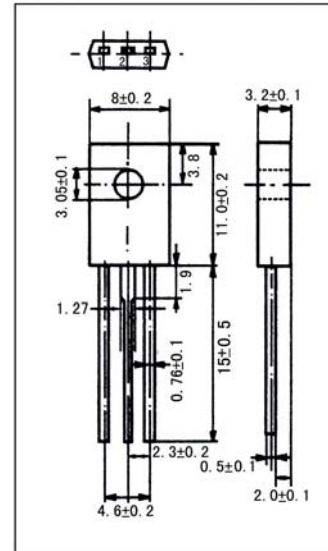
特点:与 2SD669 (3DA669)/2SD669A (3DA669A) 互补。

Features: Complementary pair with 2SD669 (3DA669)/2SD669A (3DA669A).

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V _{CBO}	-180	V
V _{CEO}	2SB649 -120 2SB649A -160	V
V _{EBO}	-5.0	V
I _C	-1.5	A
I _{CP}	-3.0	A
P _C (Ta=25°C)	1.0	W
P _C (Tc=25°C)	20	W
T _j	150	°C
T _{stg}	-55~150	°C

T0-126F 单位: mm



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V _{CBO}	I _C =-1.0mA I _E =0	-180			V
V _{CEO}	2SB649 I _C =-10mA R _{BE} =∞ 2SB649A	-120 -160			V
V _{EBO}	I _E =-1.0mA I _C =0	-5.0			V
I _{CBO}	V _{CB} =-160V I _E =0			-10	μA
h _{FE(1)}	V _{CE} =-5.0V I _C =-150mA	60		320	
h _{FE(2)}	V _{CE} =-5.0V I _C =-500mA	30			
V _{CE(sat)}	I _C =-500mA I _B =-50mA			-1.0	V
V _{BE}	V _{CE} =-5.0V I _C =-150mA			-1.5	V
f _T	V _{CE} =-5.0V I _C =-150mA		140		MHz
C _{ob}	V _{CB} =-10V I _E =0 f=1.0MHz		27		pF

h_{FE(1)} 分档/h_{FE(1)} Classifications: B:60~120 C:100~200 D:160~320

2SB649 (3CA649)
2SB649A (3CA649A)

